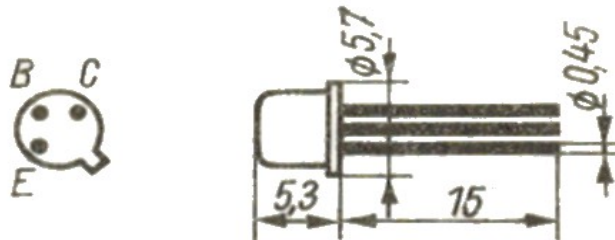


## RFT SC116 – SC117 – SC118 - SC119

Silizium- pnp- Planar- Epitaxie- NF- Transistoren



**Grenzwerte** gültig für den Betriebstemperaturbereich

	SC116	SC117	SC118	SC119	
$U_{CBO}$	= 20	30	60	80	V
$U_{CEO}$	= 20	30	60	80	V
$U_{EBO}$	= 5	5	5	5	V
$I_C$	=	100			mA
$I_B$	=	50			mA
$P_{tot}$	=	300			mW
$\vartheta_j$	=	+175			°C
$\vartheta_a$	=	-40 ... +125			°C

**Elektrische Kennwerte** ( $\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5\text{K}$ )

		SC116d	
F	(bei $U_{CE} = 5\text{V}$ , $I_C = 0,2\text{mA}$ )	typ. 2,5	dB
$f_T$	(bei $U_{CE} = 5\text{V}$ , $I_C = 10\text{mA}$ )	typ. 90	MHz

Quelle: Aktive elektronische Bauelemente – 1985